ミニマルマスクレス描画装置における リソグラフィー解像度の均一性制御

Control of the Uniformity of Lithography Resolution in Minimal Mask-less Exposure System

ミニマルファブ技術研究組合¹, PMT², 産総研³,

°北山侑司¹, 遠江栄希¹, 石井好恵^{1,2}, 入田亮一^{1,2}, 三宅賢治^{1,2}, クンプアン ソマワン^{1,3}, 原史朗^{1,3}
MINIMAL¹, PMT², and AIST³

°Yuuji Kitayama¹, Haruki Toonoe¹, Yoshie Ishii^{1,2}, Ryouichi Irita^{1,2}, Kenji Miyake^{1,2}, Sommawan Khumpuang^{1,3}, and Shiro Hara^{1,3} E-mail: yuuji.kitayama@minimalfab.com

我々は,多品種少量生産に適した半導体デバイス製造システムとして,ハーフインチ 【はじめに】 ウェハ(\$12.5mm)を最小の製造単位とするミニマルファブ構想を提唱し,その開発を進めている¹. そ の基幹となる露光については,リソグラフィーを迅速に実行できるマスクレス描画方式を採用してい る.この装置では DLP (Digital Light Processing) 方式を用いる.この装置における露光は次の手順で行 う. 光源として UV-LED (i 線 365nm) を用い, これを DMD (Digital Mirror Device) という 10.8μm 角の ミラーがフル HD (1920×1080 ピクセル) の画素数分並ぶ素子で反射させる .それを 1/20 に縮小するこ とでミラーを 0.54μm 角に縮小投影しつつ,ウェハ上にスキャンしながら描画する.リソグラフィーエ 程では、ウェハ上で均一な描画結果が得られることが重要であるが、これまでは収差やミラーの反射 率のバラつきなどに起因した露光量のバラつきがあった.前回の発表では,明るさマップという露光 量を補正するパラメータを導入することで露光量のバラつきを抑えることを示した.しかし,明るさ マップの生成には 1920 ピクセルのミラーライン 1 ピクセルずつを光量調整しなければならない . この ため、1 ピクセルずつ露光結果を見て、明るさマップの指定光量を勘所により 1 ピクセルずつ調整する という多大なトライアンドエラーを要するという課題が残されていた2.そこで,今回はレジストパタ ーンを触針式段差計を用いて ,1 ピクセルずつの形状を測定し ,ピクセル単位のレジスト膜厚と露光量 との関係性を半定量的に明るさマップへフィードバックすることで、露光量の均一化を図った、今回 は,このときの結果について報告する.

【実験】 まず,ハーフインチウェハ上に厚さ約 $1\mu m$ のレジスト膜を作成し,ミニマル装置を用いて L&S (Line and Space) のパターンを形成する.このときのレジストパターンの膜厚を触針式段差計で測定する.次に,この結果を元に,ラインの膜厚の薄い部分では露光量を減らす方に,スペースにレジスト膜が残っている部分では露光量を増やす方に,明るさマップへフィードバックを行う.その後,再度レジストパターンを形成し,触針式段差計で測定を行う.この作業を繰り返し行うことで,レジストパターンでの露光量が均一になるように最適化を行った.

【結果及び考察】 明るさマップを調整する前および,調整した後に作成したレジストパターンの光学顕微鏡画像と明るさマップを図 1 に示す.図からわかるように,明るさマップを調整することにより,2.16μmの L&S において,露光の均一性が改善された.明るさマップの詳細や触針式段差計による測定方法の詳細,フィードバックの詳細については当日報告する.

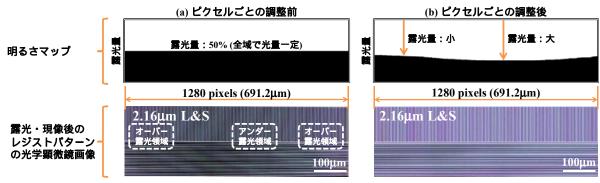


図1 露光量の(a) ピクセルごとの調整前および , (b) ピクセルごとの 調整後に作成したレジスト パターン ($2.16\mu m$ L&S) の光学顕微鏡画像と明るさマップ

【参考文献】

・ (1) 原史朗 , 前川仁 , 池田伸一 , 中野禅:「ミニマルファブシステムの構想と実現に向けて」 , 精密工学会誌 77(3),249 (2011). [2] 入田亮一 , 三宅賢治 , 梅山規男 , クンプアン ソマワン , 原史朗:「マスクレス描画装置のミニマル化」 , 第 60 回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 , 28a-G6-3(2013).